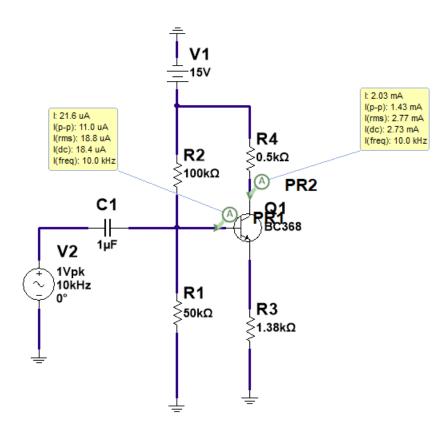
به نام خدا سوگل اصلان صفت 810198573 پروژه ی پایانی درس الکترونیک 1 دکتر سنایی

Design 1: بخش 1

Design 2: بخش 2

Design 3: بخش 3

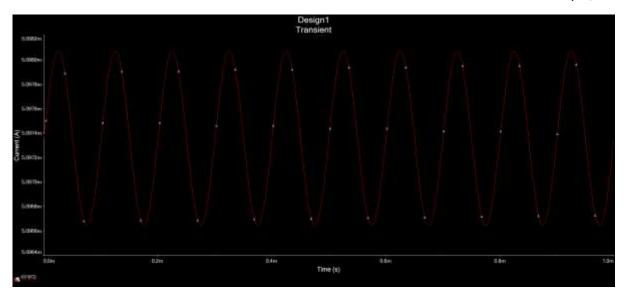
1-1 : مقدار مقاومت را به دلخواه 50 كيلو گذاشتم و مطابق تصوير زير جريان بيس و كلكتور را در مولتيسيم بدست آورده و سپس بتا را بدست آوردم



كه بتا 148.37 بدست مي آيد

1.2

1.3 همانطور که در محاسبات تئوری که در زیر آورده شده و در شبیه سازی مشخص است مقدار dc جریان کلکتور در 5میلی آمیر قرار دارد



3-1 موار DC را و استفاده از موار معا دل تونون برست س آوریم 8 JC= 5 MA -> IE = 5 MA

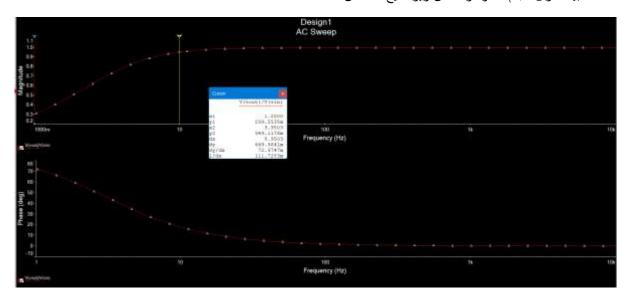
Base-Emiter KVL: VEN -Pth JE -VBEON - 138 [E=0

-> 15 Rta - Rah x5 -0.7-1.38 x 520 -> Rat= 66.+8 KS

· 200 KD // 1 Rac

• فا على كرون Bids Point من ينم به تقدار درست مرسيري.

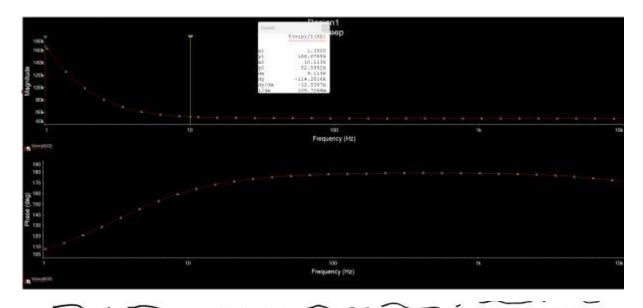
1.4 شبیه سازی انجام شد و در عکس زیر نتایج مشخص است



AC 1/2:

$$V_{in}$$
 V_{in}
 V_{in}

همانطور که از cursor مشخص است بهره ی مدار 0.95 در فرکانس 10 هرتز بدست آمده و علت تفاوت اندک آن با تئوری این است که خازن در فرکانس های پایین و نزدیک dc رفتارهای فرکانسی دارد که نمیتوان آن را ایده آل در نظر گرفت و روی سیگنال اثر میگذارد



$$R_{in} = (R_{B2} || R_{B}) || (R_{K3} + R_{Em3}(4B))$$

$$\sim R_{in} = (66.67) || (0.7 + 1.38 \times (140))$$

$$Y_{K3} = \frac{B}{J_{m_3}} = \frac{B \text{ YT}}{I_{CQ3}} = \frac{14.80.-25}{5} = 0.7 \text{ K}\Omega$$

$$R_{in} = 4 \frac{4}{3}.61 \text{ K}\Omega$$

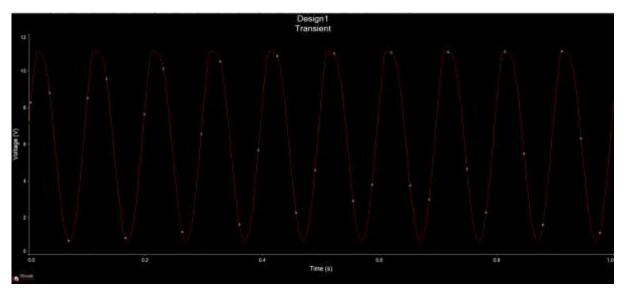
مقاومت ورودی در فرکانس 10 هرتز تقریبا منطبق است و دلیل تفاوت اندک با تئوری اثرات فرکانسی خازن میباشد

1.8 و 1.7 و 1.8

$$\Delta_1 = Roc Ican$$
,

 $Roc = R_{S}$ $\downarrow R_{Em}$,

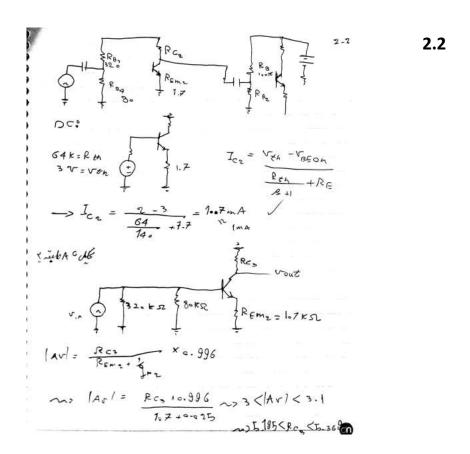
 $\Delta_2 = V_{CES_20}$
 $\Delta_2 = V_{CES_20}$
 $\Delta_3 = I_5 .1.88 I_{C=5.1}$
 $\Delta_4 = I_5 .1.88 I_{C=5.1}$
 $\Delta_5 = 4.8 \text{ T}$
 $\Delta_7 = 4.9 \text{ T}$
 $\Delta_7 = 4.9 \text{ T}$



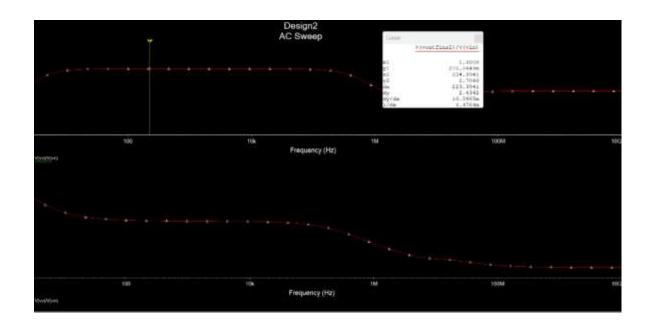
همانطور که از تصویر مشخص است حدود 5 ولت سویینگ داشتیم که تقریبا برابر با مقدار تئوری محایبه شده است

1.9

به دلیل مقاومت ورودی نسبتا بالا و مقاومت خروجی پایین به عنوان جداساز بین طبقات بکار میرود زیرا با توجه به مقاومت ورودی نسبتا بالایی که دارد لود روی طبقه ی قبل خود نمیگذارد و همچنین طبقه ی بعد خود را نیز تضعیف نمیکند و بهره ی حدود 1 دارد به علت بهره ی خوبی که دارد و همچنین مقاومت ورودی نسبتا بالای که دارد میتواند در طبقه ی اول استفاده شود



2.3



همانطور که مشاهده میشود بهره ی کلی برابر حاصل ضرب دو طبقه که 3 و 0.9 است یعنی حدودا 2.7 است که مطابق انتظار تقریبا برابر است

2.4

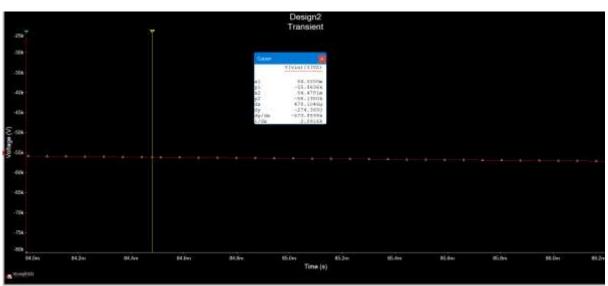
محاسبات تئوري

$$R_{in} = (R_{B3} | I^{R}_{B4}) | I(f_{R2} + R_{Em2}(1+B))$$

$$Y_{R2} = \frac{3}{9^{m2}} = \frac{14_{0.40.0.25}}{1} = 3.5$$

$$= 2 R_{in} = 6411 (3.5 + 238) = 50.6 \text{ k}.$$

نتیجه ی شبیه سازی



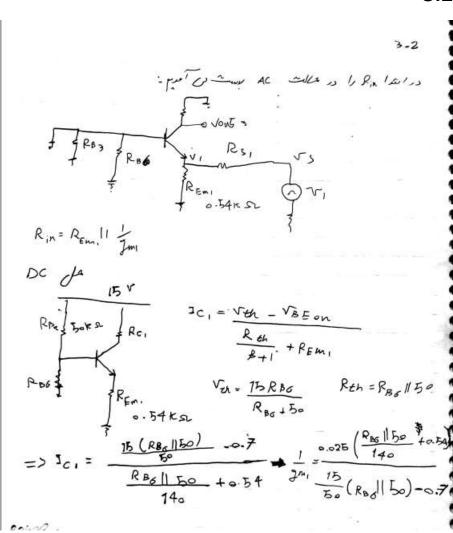
تقریبا برابر هستند و علت تفاوت جزیی این است که امپدانس خازن و همچنین اثر ارلی در محاسبات تئوری در نظر گرفته نشده

بخش 3

3.1

به علت مقاومت ورودی بالا و شیفت فازی کم و همچنین سویینگ زیاد

3.2



: ds/2.6c c/s

0.325 \(\frac{140}{140} \)

-> 0.0 975 \(\text{C} - \cdot \)

-> 0.0 975 \(\text{C} - \cdot \)

-> 0.0 98 \(\text{C} - \cdot \)

-> 0.0 98 \(\text{C} - \cdot \)

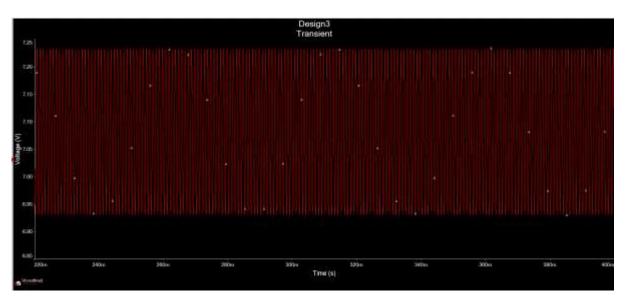
-> RBO (41.47) \(\text{C} - \cdot \)

-> RBO (42.55) \(\text{C} \)

-> RBO (42.55) \(\text{C} \)

-> RBO \(\

Veh:
$$V_{th} \times \frac{9}{8+50} = 154 \frac{9}{59} = 2,288$$
 $R_{zh} \times R_{B_5} || R_{B_6} = 9|| 50 = \frac{9 \times 5_0}{50} = 7,62$
 $R_{ch} \times R_{B_5} || R_{B_6} = 9|| 50 = \frac{9 \times 5_0}{50} = 7,62$
 $R_{ch} \times R_{ch} = \frac{1}{R_c} =$



همانطور که مشاهده میشود با ورودی 1 میلی ولت pp خروجی حدود 280 میلی ولت سوبینگ ac دارد که نشان از تقویت 280 برابری سیگنال دارد

بخش 3.4

3.4

$$AV_1 = \underbrace{AV}_{2\times A_3} = \underbrace{2.75}_{2,7} = 110$$

بخش 3.5

3.6

به دلیل اینکه مقدار بایاس دی سی هر طبقه با دیگری متفاوت است اگر خازن را برای جداسازی آنها بکار نبریم عملکرد مدار دچار اختلال میشود